Резистори – параметри, видове



Материалознание

Въпроси 25, 26, 27





Съдържание

- 1 Електронни градивни елементи
- 2 Основни параметри
- 3 Еквивалентни схеми
- 4 Нелинейни резистори





1. Електронни градивни елементи

Електронните градивни елементи служат за провеждане, обработка и управление на електрически информационни сигнали.

В зависимост от връзката между входния и изходния сигнал, елементите се разделят на:

- 1. Активни енергията на сигнала на изхода на елемента е по-голяма от енергията на входа т. е. елементът усилва тиристори, транзистори и др.
- 2. Пасивни енергията на сигнала на изхода на елемента е по-малка от енергията на входа резистори, кондензатори, бобини е др.
- 3. Линейни връзката между входния и изходния сигнал е линейна.
- 4. Нелинейни връзката между входния и изходния сигнал е нелинейна.



1. Електронни градивни елементи

При производство не могат да се осигурят всички възможнини стойности на основните параметри на елементите, а те са с определени (чрез *стандартизирани редове*) номинални стойности.

Допустимо отклонение (толеранс) на основните параметри:

$$\delta_X = \frac{(X - X_N)}{X_N} \cdot 100,\%$$

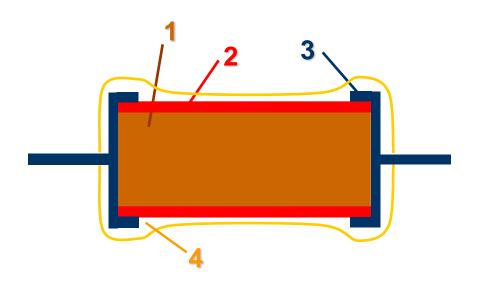
където X е реално получена стойност, а X_N – номинална стойност.





2.1. Структура и класификация

Основно предназначение – да регулира енергията на сигналите, чрез нейното намаляване, което става за сметка на разсейваната топлина в околното пространство.

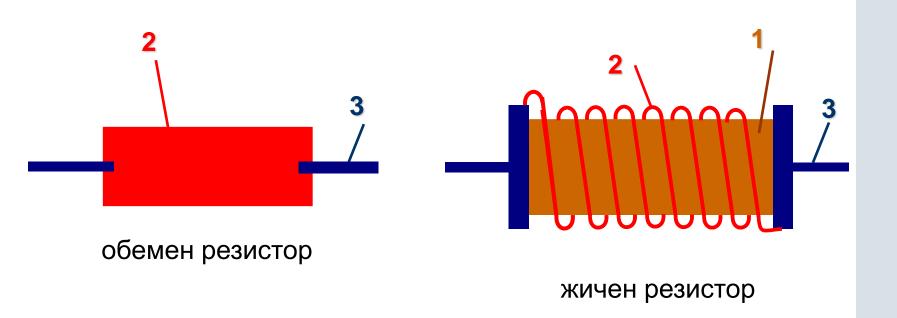


Структура на слоен резистор

1 – основа от диелектричен материал; 2 – токопровеждащ елемент от съпротивителен материал (определя основните параметри на резистора); 3 – изводи от метал с малко р (Cu) и 4 – защитно покритие от диелектричен материал.







Токопровеждащия елемент се изработва от пиролитичен въглерод, метали, сплави и метални оксиди, полупроводници и др.



По характер на изменение на съпротивлението се делят на:

▶постоянни – съпротивлението е определено при производствто и не може да се променя по време на експлоатация;

▶променливи – съпротивлението може да се регулира по механичен начин.





2.2. Основни параметри

Номинално съпротивление R_N

$$R_N = \rho \frac{I}{S}, \Omega$$

където ρ е специфично съпротивление на токопровеждащия елемент, а l и S – дължината и напречното му сечение



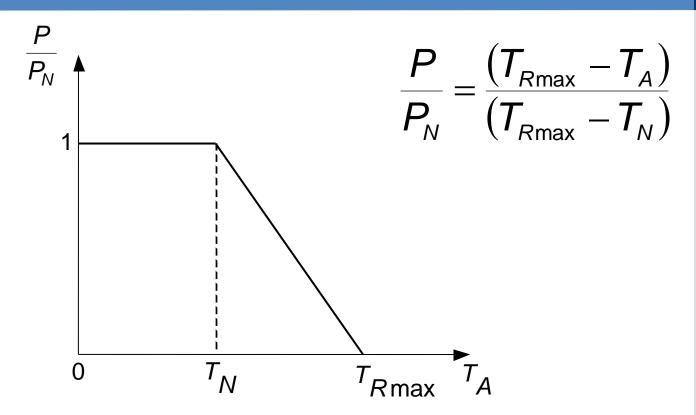
Номинална мощност P_N – най-голямата мощност, която резисторът може да разсейва продължително време при дадени експлоатационни условия със запазване на параметрите си в допустимте им граници

$$P_N = hS(T_{Rmax} - T_N)$$

където h е коефициент на топропроводимост, S – площтта, през която се извършва топлоотдаването, T_{Rmax} – максимално допустима температура, определена от материала с най-малка топлоустойчивост и T_N – номинална температура (най-високата температура на околната среда, при която резисторът може да разсейва P_N).







Ако $T_A < T_N$ резисторът може да работи неограничено дълго време при P_N ; Ако $T_N < T_A < T_{Rmax}$ резисторът може да работи при с мощност по-малка от P_N ; Ако $T_A > T_{Rmax}$ резисторът не може да работи.

При работа в импулсен режим мощността може да превишава номиналната.



Температурен коефициент на съпротивлението $lpha_R$

$$\alpha_R = \frac{dR}{RdT}, \, {}^{\circ}C^{-1}$$

Гранично работно напрежение U_{ep} — най-голямото напрежение, което може да бъде приложено между изводите на резистора за кратко време.

За нискоомните резистори то се определя от допустимото нагряване, докато за високоомните – от възможността за пробив в изолацията.





Ниво на шума – отношението на шумовото напрежение, възникващо в резистора при протичането през него на постоянен ток, към напрежението, приложено към неговите изводи.

Шумът има две компоненти:

▶Топлинен – възниква от случайните изменения на концентрацията на свободни електрони поради тяхното топлинно движение;

▶Токов – възниква от промяната на контактните съпротивления между частиците на токопровеждащия елемент при протичането на ток през него.



Собствена индуктивност L_R зависи от дължината на изводите и броя на навивките при жичен резистор.

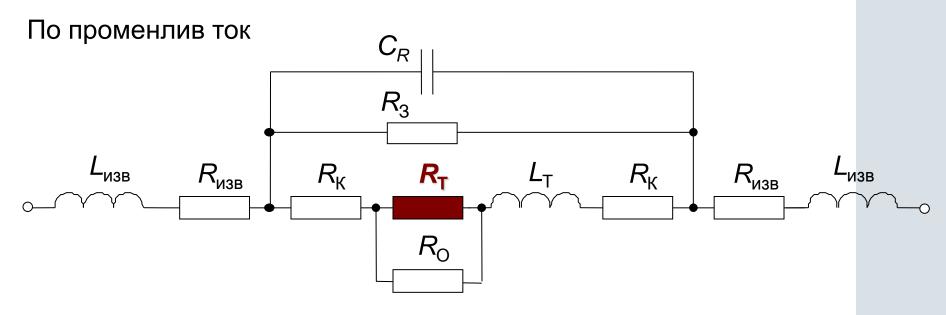
Собствен капацитет C_R зависи от геометричните размери на резистора и диелектричната проницаемост на изолационната основа и защитното покритие.

Стабилност — необратими изменения с времето в структурата поради "стареене".





2.3. Еквивалентни схеми

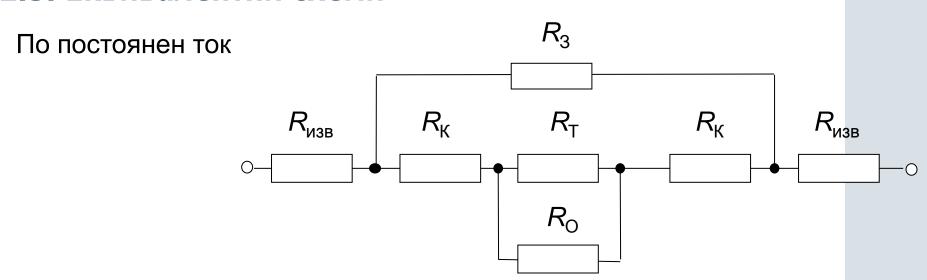


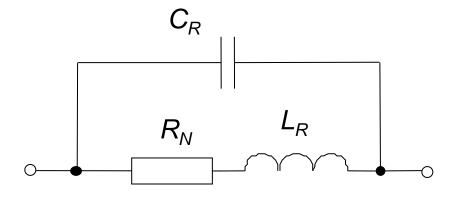
 R_T – съпротивление на токопровеждащия елемент

 $R_{\rm O}$ – на основата; $R_{\rm K}$ – на контакта между проводящия елемент и изводите; $R_{\rm use}$ – на изводите; $R_{\rm 3}$ – на защитното покритие; $L_{\rm use}$ – индуктивност на изводите и $L_{\rm T}$ – на токопровеждащия елемент



2.3. Еквивалентни схеми





Обобщена схема



3. Полупроводникови нелинейни резистори

3.1. Термистори

Изменят експоненциално съпротивлението си при промяна на температурата:

$$R_{\rm T} = A \exp\left(\frac{B}{T}\right)$$

където А и В са константи, зависещи от типа на термистора

Температурен коефициент

$$\alpha_R = -\frac{B}{T^2}$$

Приложения:

за измерване на температури от -55°C до +450°C, за термокомпенсация и др.

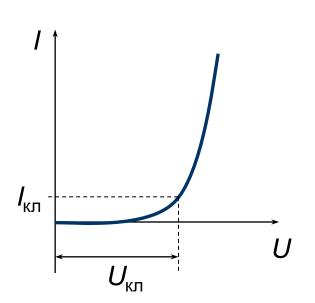




3. Полупроводникови нелинейни резистори

3.2. Варистори

Съпротивлението им зависи от стойността на приложеното напрежение.



Волт-амперна характеристика

Параметри:

- \checkmark класификационни $U_{\rm кл}$ и $I_{\rm кл}$ напрежение при протичане на ток със зададена стойност;
- ✓ номинална мощност на разсейване;
- ✓ коефициент на нелинейност описва нелинейността на волтамперна характеристика

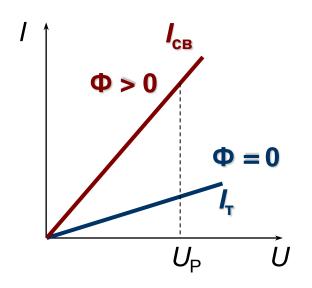
Приложение – ограничаване на напрежението (т. е. защита на схемата от пренапрежения и претоварвания).



3. Полупроводникови нелинейни резистори

3.3. Фоторезистори

Съпротивлението им зависи от осветеността. Изготвят се от ПП, които увеличават проводимостта си под влияние на светлинно лъчение с определена дължина на вълната.



Волт-амперна характеристика

Параметри:

- \checkmark съпротивление на тъмно определя се при работно напрежение $U_{\rm P}$, при липса на светлина и при ток на тъмно $I_{\rm T}$;
- ✓съпротивление на светло при осветеност от 200 lx и ток на светло *I*_{CB};
- √специфична чувствителност.

Спектрална характеристика – зависимост на фототока от дължината на вълната на лъчението.

